## 酸素ラジカルを使用したレーザ分子線エピタキシーによる LiNbO3のエピタキシャル膜の成長

## 概要

光デバイスにおけるLiNbO $_3$ には、優れた光学特性があり、光導波路スイッチ、変調器及び非線形の波長コンバータ等、光学アプリケーションには多大な関心が寄せられている。 しかしながら、現在のLiNbO $_3$ の主な用途はモバイル電話、TV、焦電センサー及び表面音波(SAW)フィルタ等である。

それらの光学アプリケーションを制限したものの理由の1つが、結晶薄膜の品質である。今回R. Fラジカルソースを装着したレーザーアプレション装置を使用し、膜を成長させた結果、高品質な LiNbO3結晶薄膜が生成された。(Appl. Phys. A 69 (1999) S.679)

膜の結果は、Fig1に示す。

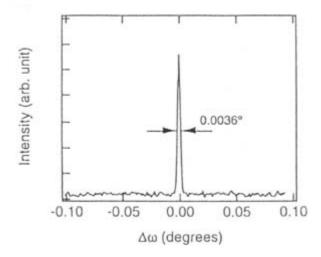


Fig.1. Rocking curve of the film around the  $LiNbO_3$  (0006) peak. The full width at half maximum was about 0.0036 °, which was comparable to that of bulk crystals

\*上記文献及び実験データは、電子総合技術研究所 光技術部 松原様より御提供頂きました。